

KONTROLLÜ SİLİKON DOGRULTKAN (KSD)

Derleyen: **Gürcan KARAGÖZ**
ODTÜ

ÖZET

Bu yazımızda, kontrollü silikon doğrultkanının (KSD) çalışma prensipleri ve kullanılma yerleri incelenmiştir.

SUMMARY

In this article, the principle of operation and the application of silicon controlled rectifier (SCR) is presented.

1. GMS :

Kontrollü silikon doğrultkan (KSD) 1957 yılında ilk defa yapılmış ve devamlı olarak da gelişmektedir. Bu yan geçirgen eleman bugün bütün anahtarlama devrelerinde bağan ile kullanılmaktadır. Bu gür. cıvalı! doğrultkanın ve tyratronların hemen hemen yerini almıştır, örneğin 1300 volt ve 500 amper seviyelerinde çalışanları bulmak mümkündür. Bu kadar büyük bir gücü 0,5 vat gibi düşük bir güç ile kontrol etmek (KSD)'nin gelecekte bir çok kontrol devresinde kullanılacağını kanıtlar.

Kontrollü silikon doğrultkan üç uçludur. Buna anot, katot ve kapıdır, kapı, anot katot arasında kontrol ödevini yapar.

(KSD)"nin avantajlarının], söylece sıralayabiliriz :

- Yüksek güçleri kontrol edebilir,
- Üzerinde az güç harcar,
- Kuzu bir çalışması vardır,
- Çok fazla duyarlığa sahiptir,
- Uzun ömürlüdür,
- Randımanı fazladır.

(KSD)'nin iletimde ve kesimde olmak üzere iki farklı durumu vardır. Geçirmsiz durumda empedansı oldukça yüksek ve 10.000 om civarındadır, geçirgen durumda ise bu değer 0,01 om'a kadar düşebilir.

2. (P-N-P-N) Prensibi :

(KSD)'nin çalışması p ve n tipi silikon katlarını and arda p-n-p-n diye gelmesi ile oluşur. N tipi yarı geçirgenlerde atam negatif (elektron), P tipi yarı geçirgenlerde ise pozitif (delik) taşıyıcılar tarafından taşınır. P ve N tipi iki tabaka yan yana birleştirilirse 'böyle bir birleşme tek yönde geçirme özelliği gösterir. P kısmını N kısmına göre pozitif toplu gerilim altında bırakılırsa böyle bir birleşme yeri ileriye doğru öne itilmelidir. Denir ve akım 'geçer'. P kısmına N kısmına göre negatif bir gerilim uygulanırsa,

böyle bir birleşme yerine ters ön akımlanmış denebilir, ve çok az bir akım geçer. ŞeMC 3'de bu dört katlı (P-N-P-N) anahtan görülmektedir.

ANOT

ANOT

J2 =

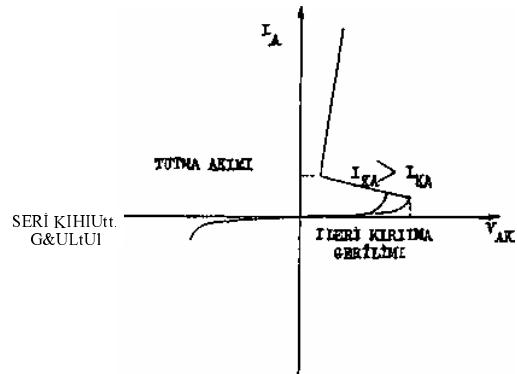
KAPI

UI

KATOD

KATOT

Bu (P-N-P-N) tek yönlü iletken Şekil Z'de görülen (V -1) karakteri verir.

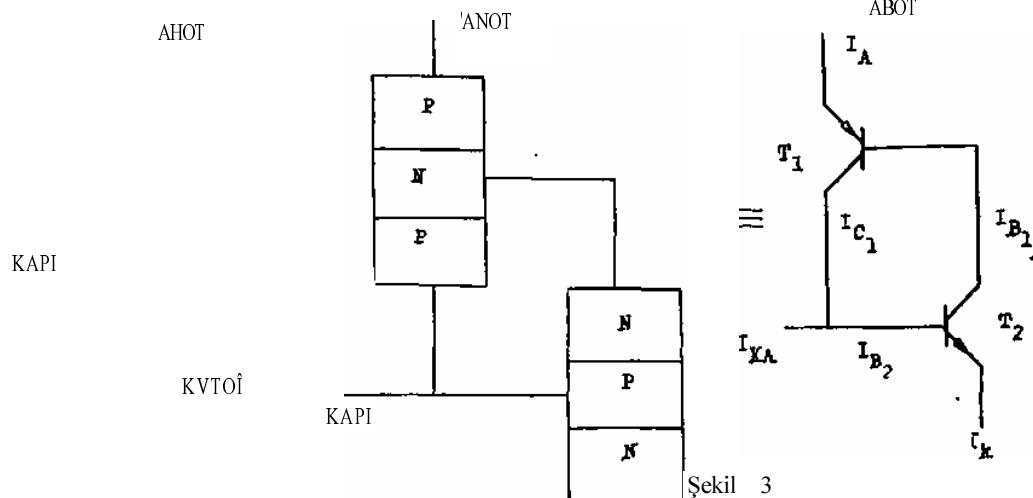


ileri kınlama gerilimi kapı akımına çok bağlıdır. Kapı akımı arttıkça ileri kınlama gerilimi düşer. Şekil 2'den şu sonuçlar irdelenebilir :

1 — V_{AK} sabit bir değerde tutulur ve gerekli akım kapıya tatbik edilirse KSD iletken duruma geçer ve üzerinde ufak bir gerilim düşümü olur (1 volt).

'2 — Kapı akımı¹ I_{KA} sabit tutulur ve V_{AK} belli, bir "değere getirilirse KSD< iletken 'durguna geçer.

3 — Kapı akımı siür 'bile olsa, $V_{AK} = ma$, belli bir değeri KSD*yi iletken duruma getirebilir.



3 — Transistor Benzetimi :
P-N-P-N tek yön geçirgeni Şekil 3'de belirtildiği gibi pnp ve npn iki transistorun bağlanmasından meydana gelmiş gibi düşünülebilir.

pnp transistorunun baz akımı

$I_B = \frac{1}{a_2} (V_{CB} - V_{BE})$ (CBO = ters
ön atomlanmış kollektör - baz
birleşim yerinin sızıntı akımı), npn
transistorunun kollektör akımıdır.

akımdır. Böylece pnp ve npn tansistorlerindeki atom artıştan $\propto + \& \approx = 1$ oluncaya kadar devam eder ve böylece transistorlar doyuma gider.

Şekil 4'de a ile emetör akımı arasındaki ilgi görülmektedir.

c_1 c_2

$$I_K = I_A + I_K A$$

$$I_A = (a_2^{-1} K_A + I_{CBO1} + I_{CBO2}) / t^1 - (a_1 + 0.2)^{-1}$$

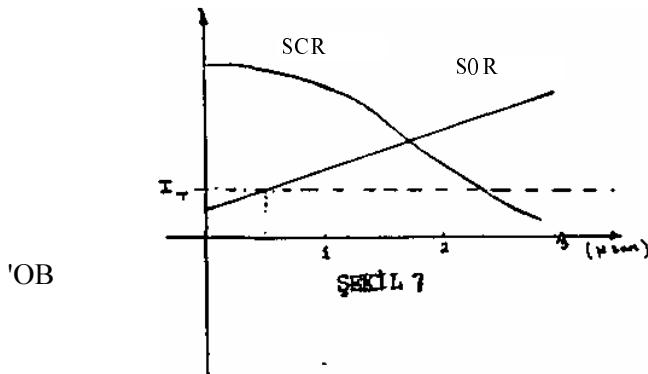
$\propto i_1 + \propto x_2 = 1$ olduğu zaman KSD'den geçen akımı¹ yalnız dış devre sınırlar ve (KSD) iletken durumundadır. (KSD)'nin anoduna bir direnci seri olarak bağlayalı ve anot pozitif olmak üzere bir gerilim tatbik edelim. Kapıya uygulanan gerilim. katoda göre negatif olsun, npn transistoru kesimdedir ve npn transistorunun kollektöründen de atom geçmediği için npn transistoru de kesimdedir. Anot ile katot arasındaki empedans çok yüksektir. Şimdi kapıya pozitif bir gerilim uygulayalım, npn (geçirgenliği başlar ve npn'in kollektör akımı pnp transistorunun baz akımıdır. Bu baz atomu pnpMe kollektör akımı meydana getirir. Pnp'nin kollektör akımı npn nin baz

ŞEKİL 4

Her iki transistor de doyuma gittikten sonra kapı artık kontrolü kaybeder. Kapıya negatif bir gerilim uygulasak bile KSD geçirgen durumda kalır.

$\propto 1 + a_2 = 1$ koşulu kollektör - emetör geriliminin artırılması ile de elde edilebilir.

ŞEKİL 5

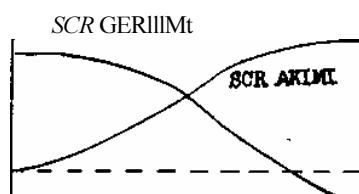


Şekil 5 de görüldüğü gibi V^A yükseltilir, bu $\approx 1 + 10a = 1$ oluncaya kalar devam eder. $\approx 1 + 2 = 1$ olduğu zamanki (KSD) anot katot gerilimine, ileri kırıtlım gerilimi ve bu andaki anot akımına tutma akımı denir.

4. Ateşleme :

(KSD)'yi geçirgen duruma sokmak için yapılan J şleme ateşlisine veya tetikteme denir. (KSD)'nin kesiminde durumdan iletken duruma geçme zamanı¹ (KSD)'nin anahtarlama sırasında güç kaybını belirler. Anahtarlama zamanı ne kadar uzun ise o kadar güç (KSD) üzerinde harcanır.

Anahtarlanan devrede yalnız direnç var ise, (KSD) geriliminin azalma oranı akımın artma oranı ite orantılıdır ve son değer olarak yaklaşık 1 volta iner. Anahtarlama zamanı Şekil 6'da gösterilmektedir. Anahtarlama 1-3 mikrosaniye içinde olur.



Anahtarlanan devrede bir bobin varsa akımın artma oranı $R - L$ devresinin zaman sabitesi tarafından sınırlanır. Bu Şekil 7'de gösterilmüktür.

Eğer kapıya uygulanan puls $>$ (KSD) akımı tutma akımı¹ değerine varmadan geri çekilirse (KSD) iletme geçemez. Bu durumda (KSD) transistor gitri davranışları. Bu şartı sağlamak için,

$$t_T < (V/R) [1 - \exp(-t/(L/R))]$$

akım tutma değerine 1 mikro saniyede çıkış şartı¹ kabul edilirse,

$$t_T < (V/L) 10^{-6}$$
 olmalıdır.

Genel olarak, kapıya uygulanacak pulsun süresi belli bir değerden aşağı olamaz. Pulsun süresi ne kadar kısa olursa -genliği o kadar fazla olmalıdır. Süresi 0,2 mikro saniyeden kısa olan pulslar nadiren (KSD)'yi iletme geçirir. Bununla beraber uygulanan akım pulsun yükselme zamanı kısaldıkça, anahtarlama da o kadar hızlı olur. Örneğin 10 A/mikrosaniyelik bir yükselme zamanı olan 1bir puls (KSD)'yi 0,1 miksaniye içinde iletme geçirir.

5. -Söndürme :

(KSD)'yi kesime sokmak için akün, tutma akımının altına düşürülür veya anot katot arası ters bir gerilim uygulanır. (KSD) fyi en hızlı bir şekilde kesime bu ikinci metot sokar (7 - 20 mikro saniye). Birinci metot uygulanırsa bu zaman daha fazladır (100 mikro saniye).

6. Tetikleme Devreleri :

(KSD)'yi geçirgen duruma getiren tetikteme gerilimi 2-10 volt, akjumi ise 100 mikro amper - 1500 mili amper arasında değişir. Bütün bu değerler transistor veya magnetik yükselteç ile sağlanabilir.

6.1. DC ateşleme işaret :

$t = t_1$ anında S anahtarını kapayalım. Bu anda (KSD) iletme geçer, bütün AO sinyali yük üzerinde görülür. Bu AÇ işaretini yön değiştirinceye kadar devam eder. Böylece yükün içinden tek yönlü bir akün geçer (Şekil 8).

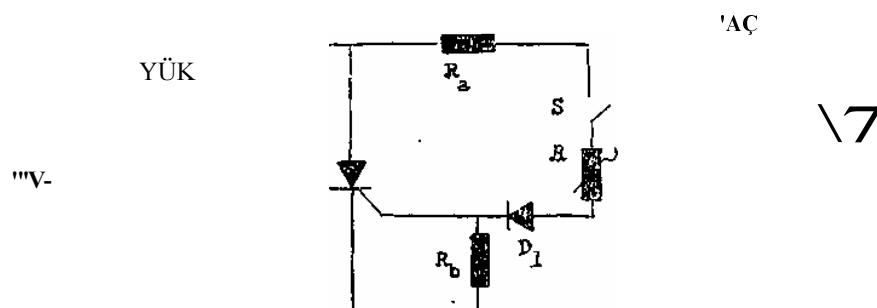
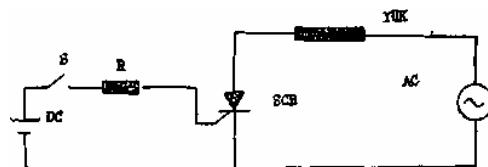
6.2. Direnç tetikte me devresi :

Şekil 9M görüldüğü gibi KS'yi eleklemek için gerekli klimi, gerilimi bir direcle düşürerek elde edilir.

Yük kımı; $R + R_o$) ve \hat{i} meyd. ge-
irdiği gerilim bölü \ddot{u} belir. işi gerilim k. iyı
e kikl'eyi eye k. d'r geçmez. Ge ikme çis 1_a R
yrl. r k. değiş irilebilir, f k. 90° yi g -m z
Yük dire. i üzeri de is e ile güç, değişke ibl.
dire ç y rdımı ile is e ile değere ge l-rilelb. lr
K. i kımı i em iye li bir seviyede • u m k
ici

$R_a + R)$: E/I_{KAM} s g1 m 11dir * KAM

K 1 k1m1 1 m ximum değeri Ay



SCR

SEKiL : 9

$R + R_a) = E - V_{KAM} / R_b / V_{KAM}$ 11 m 11dir

VKAM = $\frac{K \cdot P}{I}$ gerilimi ile xlmum değeri
Böyle ekipmey gele iş re KS)'yi bzm z

8.3. RC tetikteme devresi :

ire ç e ikleme levresi de a ge ikme çisi-
 1 90° de f zl l miy g̃im belir misik
 RC e ikleme devresi de, AÇ gerilimi i f zi de-
 ğis irilerek k iy bik edilir ve a, diger bir
 deyişle yük e h r güc degis irilebilir



KS) gerilimi eg if ldugu
 z m , k d s ör AC gerilimi i eg if e e
 degeri e , y lu ile yucle ir ve bu sir d KS)
 kesimdedir AC gerilimi zi if lu k d -

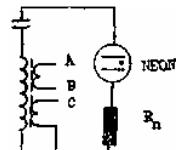
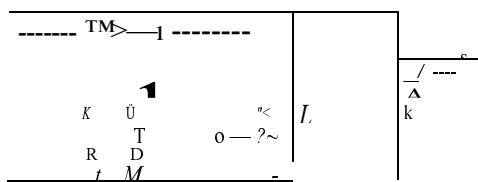
sörzi if AÇ gerilimi e R y lu üye yükle me-
ye b sl r

V_c değeri e i k e me V_{KA} + V_D , değeri e geli e K S);yi eşler V_{DI} diy gerilim)- WRC' i bir f ksiy u l ^a yi liik l - r k bulm k ldukç güc ür K S)"ye' z r r vermemek ici

$R < B - V_{D1} - V_{KA}$ / I_{KA} değeri seçilmelidir

6.4. Neon lambalı tetikleme devresi :

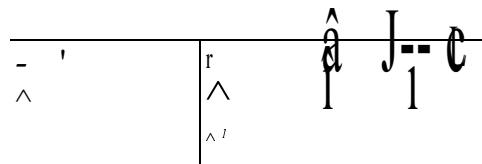
Ne 1 mb sı y rdımı ile KS) eşle ebi-
lir Y iliş sekli e göre e 1 mb 1 rı 0 - 00
v 1 r sı d eşle ebilir Ne 1 mb eşle ir
eşle mez dire i uf lı r ve bu b głı 1 r k
üzeri deki gerilim, düşer Eğer 1 mb ile r lel
bir k d s ör v r ise k d s ör b ş lm y
b ş l r Şekil ll'de böyle bir eşleme devresi
görülmek edir C t k d s örü AÇ iş re i i
her değişimi de d 1 r Ne eşlediği z m d
gerilim b ş lm sı lur Bu g lm uls r sf r-
m örü ü y rdımı ite KS)'eri eşle mesi de
kull ılır R sly me resi e ikleme z m 1 l
y rl rr



gentü

6.5. Doyabilir reaktör ite tetikleme :

Reaktör B - H eğrisi dikdörtgen şeklinde olan bir bobindir. Doymuş durumda empedansı düşük, doymamış haldeki empedansı ise büyütür. Şekil 12*de böyle bir reaktörün bir (KSD)'yi nasıl tetikleyeceğini görülmektedir.



A noktası pozitif olduğu zaman DR içinden akım, geçer. DR'den geçen bu akım DR'yi doymug hale sokar ve doymuş haldeki DR'nin empedansı düşük olduğu için (KBD)'nin kapısını tetrüyemez. A noktası negatif iken (KSD) kesimdedir. A noktası pozitif anında kontrol sarımına Şekil 12'de gösterilen kutuplamada bir DC uygulanırsa, DR doyundan çıkar ve üzerinde düşen gerilim (KSD)'yi tetikler.

(KSD) devrelerinde tetikleme en çok UJT (uni - junction transistor) denilen tek bireşim yeri olan bir transistörle yapılmaktadır. UJT ül-kemizde çok az tanındığı için, yazımızda ondan, bahsedilmemiştir, iterdeki yazılarımıza bahsetmeyi düşünmektedir.

T. Söndürme :

Buraya kadarki devrelerde, (KSD)'yi anoduna gelen negatif AÇ söndürmeye idi. Bu kısımda DC devrelerinde (KSD)'nin söndürülmesi incelenecktir.

(KSD)'yi kesimde duruma sokmak için aşağıdaki metodlar uygulanın:

- i) Anoda negatif gerilim verilir.

ü) Anot akımı tutma akımının altına düşer. iÜ) Anot gerilimi sıfıra düşürülür.

Şimdi çeşitli söndürme devrelerim incelyelim.

R

SCR

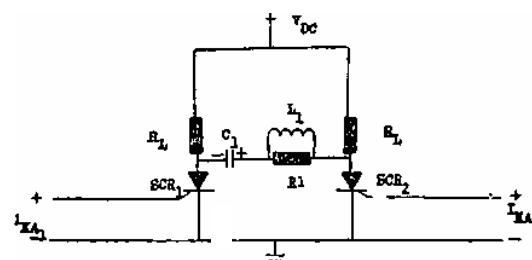
ijEKtL 1? a

Şekil 13 a'da görülen S anahtarı açıldığı zaman (KSD) sorunu;; olur.

C z

ŞEKtL 1?

Şekil 13 b'ye görülen devre kendine söner. Kondansatör gerilimi V_{DC} ye yaklaşırken, akım, tutma akımıını altına düşunce (KSD) söner.

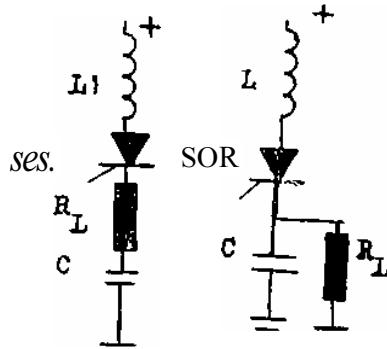


Şekil 13 c'ye görülen devre bir dengesiz multivibratöre benzemektedir.

KSD₂'yi söndürmek için de KSD₁'in iletimde olması gerekmektedir. Devredeki R_{j1}^* , ters akımı sınırlamak içindir. Bu devrenin çalışabilmesi için her iki kapının aynı anda ateşlenmemesi gerekmektedir. KSD₁'in iletimde KSD₂'nin kesimde ol-

düğünü düşünelim. C_1 şekilde gösterildiği yönde yüklenecektir. KSD'nin bu anda ateşlendiğini düşünelim.

C_1 üzerindeki gerilim olduğu gibi KSD'in anodu üzerine düşecek ve onu söndüreceklerdir. Böylede toırıbnınl takip edecek pulsalar KA₁ ve KA₂, ye geldikçe KSD₂ ve KSD₁ verilen sjra içinde soneceklerdir. Burada her iki KSD'nin aynı güçte olma zorunluğu yoktur. Küçük güçlü KSD'ler büyük güçleri söndürebiller.



ŞEKİI Z? İ §2KİL

Şekil 13 d ve 13 e'de R G, L, sonümlü bir titream olacak şekilde hesaplanmıştır. (KSD) iletme gectiksin sonra, kondansatörde blrlikken enerji titreame gelir ve titream akım) yön değiştirirken de KSD'yi söndürür. Bu şartın sağlanması için Şekil 13 d'de

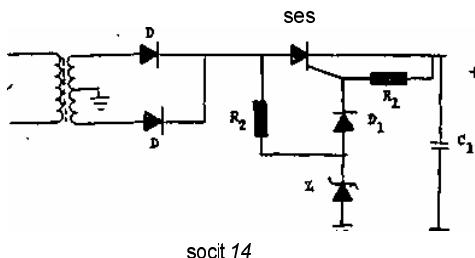
$$R = \frac{V}{4L/C}$$

ve Şekil 13 e için $R_L = VL/4C$ olmalıdır.

8. örnek Devreler

Buraya kadarki bölümlerde, (KSD)'nin çalışma prensipleri verilmiştir. Bu bölümde çeşitli devrelerde (KSD) nin nasü kullanıldığını göreceğiz.

8. KSD regülatör :

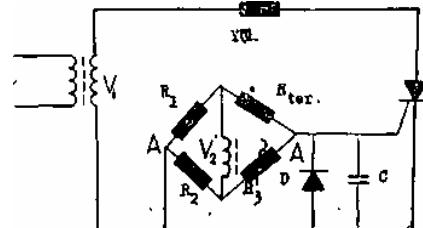


şocit 14

Zener diyon, (KSD)'nın kapısında referans gerillmini belirler. Çıkış kondansatörünün üzerin-

deki gerilim zener gerilimin altına dügünce KSD ateşlenir, çucufe gerilimini artırır. D₁ diyonu zener diyonun akımını sınırlayan R₁ direncini izole eder.

8.2. Sıcaklık kontrolü



statti. 15

ŞeMI 15 de görülen devre bir yük üzerindeki sıcaklığı sabit tutmak için kullanılmaktadır.

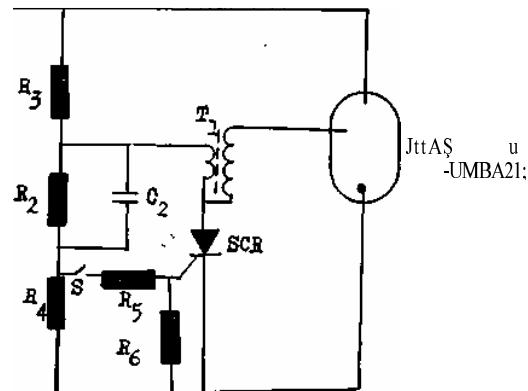
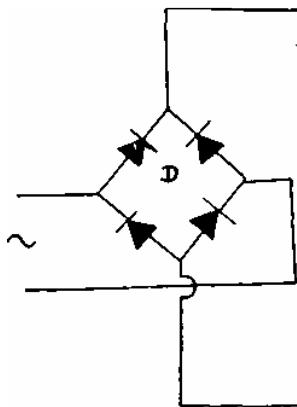
Transformatörün iki tane ikindi sarımı vardır. Birincisi V_j, yükü besler, ikincisi ise bir kenarj termistör (isınınca direnci düşen) olan bir köprüyü besler. Termistörün direnci B₃ direncinin değerine eşit olunca köprünün A - A uçlarında hiç bir gerilim görülmeye ve KSD kesimdedir. Şimdi R₁ düşürelim dengesi bozulan köprü üstündeki gerilim (KSD)'yi ateşler. Yükün yanına yerleştirilen termistörün direnci düşmeye başlar. R_T = R₃ olunca A - A da gerilim sıfır olur, akım yön değiştirdiği zaman (KSD) söner. Böylece (SCR) ateşlenerek ve sonek yük ısısını sabit tutar.

8.3. Elektronik flaş : 1

Diyot köprüsü yardımı ile O₁ ve O₂, belli dēerlere dolarlar. S anahtarı kapatılır kapatılmaz, (KSD) ateşlenir ve O₁, T_j üzerinden boşalır. T_j in ikincil sarımında meydana gelen yüksek gerilim flaş lambasını ionize eder. C_a kondansatörü boşalarak flaş lambasının dolmağı saglar. T_j in C₂ titreserek (KSD)'yi birincil sanma ile söndürür (Şekil 16).

8.4. (AC/DC) işeri (motorunun hız kontrolü :

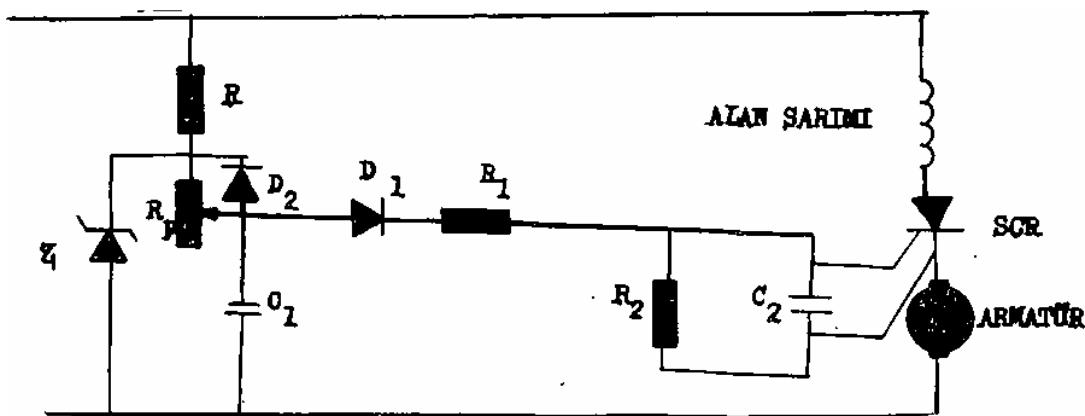
Seri motorların bilindiği gibi belirli bir karakteri vardır. Yük arttırdığı zaman motor hızı düşer, yük kaldırıldığı anda ise fazla hızlanır. Dēisen yüklerde ise sabit bir hız elde etmek için geri besleme gerekmektedir. Şekil 17'de verilen devre armatürde hızla orantılı bir gerilim yaratmak için motordaki artık alandan faydalananmaktadır. Motor armatürü hareketsiz durumda iken, artık alandan dolayı armatürde hiç bir gerilim m'eydana gelmez. (KSD) hemen ateşlenir ve motor hızlanmaya başlar. Motor hızlanın-



ŞKEti 16

ca hızla orantılı olarak artık gerilim artar. Armatürdeki bu artık gerilim (KSD).nin ateslenebilmesi için kapı geriliminin daha yüksek değerle re çıkışmasını gerektirir. Böylece gecikme açısı artır ve motor kararlı bir hızla döner. Eğer motora

bir yük tatbik edilirse, hızı azalmaya başlar. Buna orantılı olarak armatürdeki artık gerilim düşer ve otomatik olarak gecikme açısı ufalır ve hızı artar. Şekil 17.de böyles bir kontrol devam devresi görülmektedir.



ŞEKtL: 17

REFERANSLAR

- 1) Saul Keller, Understanding Silicon Controlled Rectifiers. New - York, Hayden, 1968.
- 2) Allan Lytel, Silicon Controlled Rectifiers. Indianapolis, Howard W & Sams, 1968.
- 3) Allan Lytel, Electronic Motor Control. Indianapolis, Howard W & Sams, 1964.
- 4) Grifflin & Ramshaw, The Thyristor and its Applications. London, Chapman & Hall Ltd., 1965.
- 5) Gentry - Von Zastrow, Semiconductor Controlled Rectifiers. New-Jersey, Prentice Hall, 1964.
- 6) Elektronik Experimenters (Popular Electronics), 1965.
- 7) Peter Volkov, In'eçpenslve SCR regülatör. Electrondos, Feb. 5, 1968.